



复旦微电子

# ***FM11NT082C***

## ***NFC 双界面标签及通道芯片***

技术手册

---

2022. 3



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不保证本资料中不含任何瑕疵。

本资料不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

## 商 标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。

# 章节列表

章节列表 .....	3
1 说明 .....	5
2 产品综述 .....	6
2.1 产品简介 .....	6
2.2 产品特点 .....	6
2.2.1 非接触接口 .....	6
2.2.2 接触接口 .....	6
2.2.3 双界面 .....	7
2.2.4 EEPROM .....	7
2.2.5 安全特性 .....	7
2.3 结构框图 .....	7
2.4 引脚说明 .....	7
2.4.1 TDFN10 .....	8
2.4.2 SOP8 .....	9
3 功能描述 .....	10
3.1 总体描述 .....	10
3.2 存储器 .....	10
3.2.1 概述 .....	10
3.2.2 组织结构 .....	10
3.2.3 UID/Serial Number .....	14
3.2.4 CL Static Lock Bytes .....	14
3.2.5 CL Dynamic Lock Bytes .....	14
3.2.6 CT Lock Bits .....	15
3.2.7 AUTH KEY .....	17
3.2.8 AUTH0 .....	17
3.2.9 USER CFG .....	17
3.2.10 Capability Container .....	17
3.2.11 CC 区出厂初始化 .....	18
3.2.12 双界面访问权限仲裁 .....	18
3.3 寄存器 .....	19
3.3.1 概述 .....	19
3.3.2 系统寄存器列表 .....	19
3.3.3 系统寄存器详细定义 .....	19
3.4 电源管理 .....	23
3.4.1 概述 .....	23
3.4.2 电源方案 .....	23
3.5 安全认证 .....	24
3.5.1 安全算法 .....	24
3.5.2 下行安全认证 .....	24
3.5.3 上行安全认证 .....	25
3.6 非接触接口 .....	26
3.6.1 概述 .....	26
3.6.2 指令格式及简要说明 .....	26
3.7 I <sup>2</sup> C 接口 .....	31
3.7.1 概述 .....	31
3.7.2 I <sup>2</sup> C 接口上电唤醒 .....	32
3.7.3 接口时序 .....	32
3.7.4 I <sup>2</sup> C 接口工作流程 .....	33



3.7.5	I2C 接口对片内存储器的访问.....	35
3.7.6	I2C Timeout.....	36
<b>4</b>	<b>应用指南 .....</b>	<b>37</b>
4.1	总体描述.....	37
4.2	非接触接口通信原理.....	37
4.3	场能量对外供电.....	38
4.3.1	概述.....	38
4.3.2	供电能力.....	38
4.3.3	开关配置.....	38
4.4	典型应用电路.....	38
4.4.1	非对外供电应用.....	38
4.4.2	对外供电应用.....	39
<b>5</b>	<b>电气参数 .....</b>	<b>41</b>
5.1	极限额定参数.....	41
5.2	推荐工作条件.....	41
5.3	电参数.....	41
5.3.1	管脚电参数.....	41
5.3.2	芯片电参数.....	42
5.3.3	I2C 接口交流参数.....	42
5.4	存储器参数.....	43
<b>6</b>	<b>封装信息 .....</b>	<b>44</b>
6.1	TDFN10 封装.....	44
6.2	SOP8 封装.....	45
<b>7</b>	<b>订货信息 .....</b>	<b>46</b>
	版本信息 .....	48
	上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服网.....	49



# 1 说明

FM11NT082C 是复旦微电子公司开发的符合 ISO/IEC14443—A 协议的 NFC 双界面标签及通道芯片。请联系复旦微电子公司提供更多相关文档支持详细设计开发。

## 2 产品综述

### 2.1 产品简介

FM11NT082C（以下简称 NT082C）是复旦微电子公司开发的第二代符合 ISO/IEC14443—A 协议的 NFC 双界面标签芯片。

NT082C 内置 EEPROM，可用于外部主控 MCU 和 NFC 手机或读写器之间的非实时的数据交互，比如：由 NFC 手机向 EEPROM 中写入配置信息，外部主控 MCU 空闲时再进行读取；或者设备运行的 LOG 文件定时写入 EEPROM 中，NFC 手机可以在设备不上电的情况下读取 LOG 文件。也可以利用读写 EEPROM，实现 MCU 和手机之间的实时的慢速数据交互。

NT082C 内置 FIFO，可以为只有接触接口的外部主控 MCU 提供一个非接触通道，使外部主控 MCU 可以和读写器或 NFC 手机进行实时的数据交互。

NT082C 的非接触接口具有双向安全认证功能，下行认证方式为读写器对标签的认证，可用于电子产品的防伪及原厂验证，以及区域销售管理；上行认证方式为标签对读写器的认证，可用于个别功能的使能及存储空间权限的访问控制等。

支持非接触场能量收集及对外供电功能，配合低功耗 MCU，可应用于一些便携式 NFC 应用。

NT082C 集成了场强测量功能，借助该功能，配合一定的操作流程，可以完成 NFC 手机和标签之间的精准对位。

### 2.2 产品特点

#### 2.2.1 非接触接口

- 通讯协议：ISO/IEC 14443—A
- 工作频率：13.56MHz
- 数据传输速率：106 Kbps
- 采用 16bit CRC 保证数据完整性
- 支持 7 bytes UID，两重防冲突
- 支持快速数据初始化功能
- 场能量收集及对外供电功能
- 场强测量功能

#### 2.2.2 接触接口

- 零待机功耗
- 多种上电唤醒方式
- 工作电压范围：2.2V~5V
- I2C 最高数据传输速率：1Mbps
- 支持寄存器软复位功能

### 2.2.3 双界面

- 双界面访问权限：可配置为先到先得、或接触界面优先、或非接触界面优先、或无优先级
- 双界面共享的 32 字节数据缓存 FIFO

### 2.2.4 EEPROM

- 总容量：1K Bytes
- 用户区容量：888 Bytes
- 最大擦写次数：100 万次
- 数据保存时间：20 年

### 2.2.5 安全特性

- 每颗芯片拥有独立 7 byte UID，UID 不可改写
- CC 区有 OTP 功能，具有抗撕裂能力
- 存储区具有只读锁定功能
- 基于算法的双向安全认证
- 场内隐身功能
- 用户安全数据区大小可调节，对安全数据区的访问权限受算法控制

## 2.3 结构框图

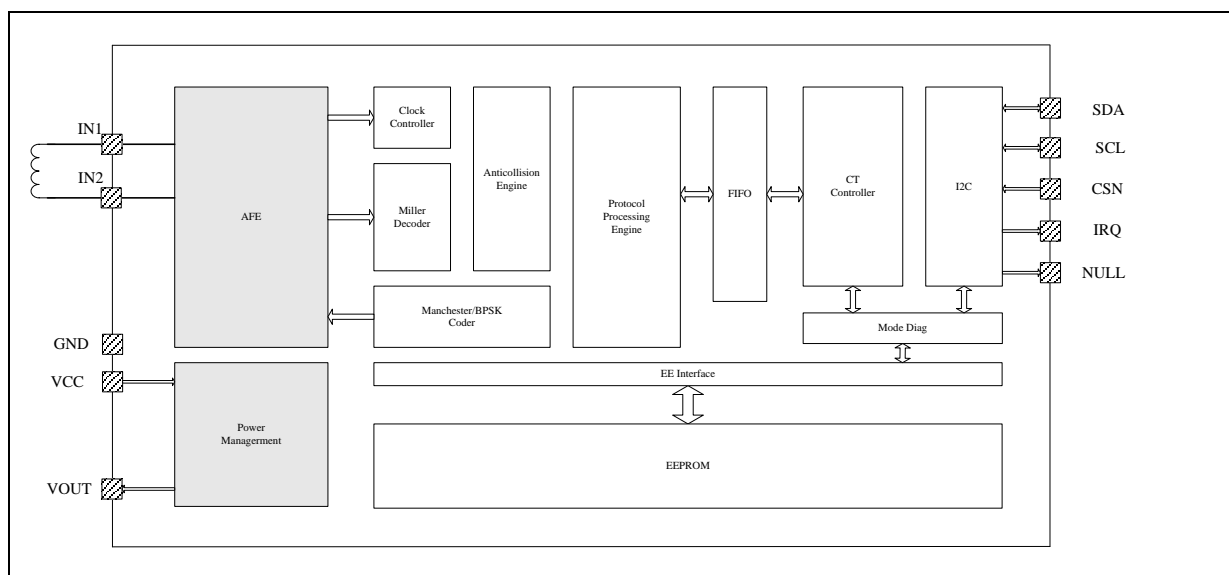


图 2-1 结构框图

## 2.4 引脚说明



2.4.1 TDFN10

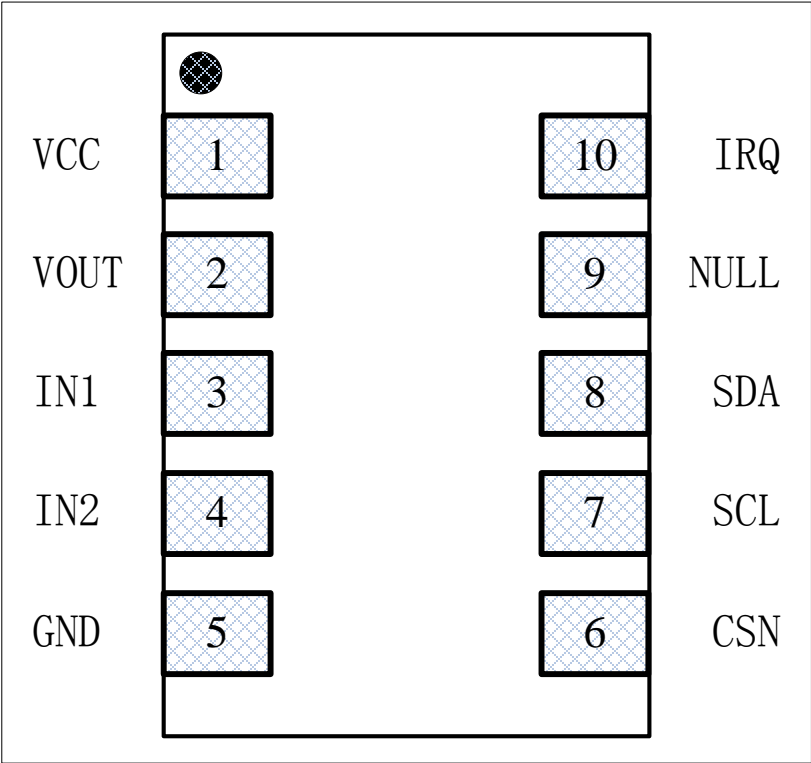


图 2-2 TDFN10 引脚说明图

编号	管脚名称	管脚类型	说明
1	VCC	电源	接触界面的电源
2	VOUT	模拟输出	场能量整流稳压后输出
3	IN1	模拟输入	射频天线引脚
4	IN2	模拟输入	射频天线引脚
5	GND	地	芯片地
6	CSN	数字输入	接触接口电源开关使能信号（低有效），片内弱上拉
7	SCL	数字输入	I2C 时钟信号端口
8	SDA	开漏输出	I2C 数据信号端口
9	NULL	-	-
10	IRQ	数字输出	中断信号输出，可配置为推挽高有效或开漏低有效

表 2-1 TDFN10 封装引脚列表



## 2.4.2 SOP8

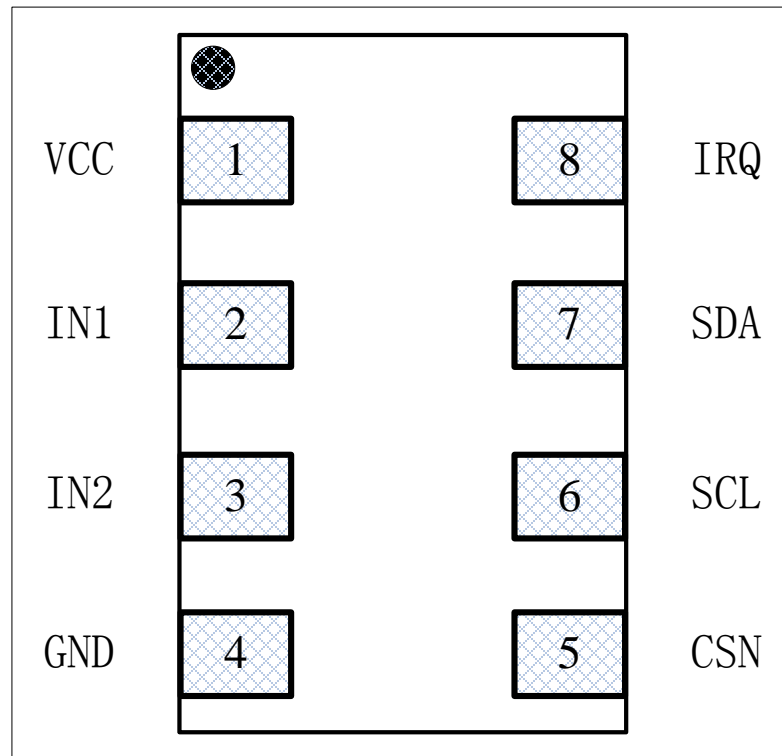


图 2-3 SOP8 引脚说明图

编号	管脚名称	管脚类型	说明
1	VCC	电源	接触界面的电源
2	IN1	模拟输入	射频天线引脚
3	IN2	模拟输入	射频天线引脚
4	GND	地	芯片地
5	CSN	数字输入	接触接口电源开关使能信号（低有效），片内弱上拉
6	SCL	数字输入	I2C 时钟信号端口
7	SDA	开漏输出	I2C 数据信号端口
8	IRQ	数字输出	中断信号输出，可配置为推挽高有效或开漏低有效

表 2-2 SOP8 封装引脚列表

## 3 功能描述

### 3.1 总体描述

芯片由三部分构成：

- 模拟前端电路
- 数字逻辑电路
- 非易失性存储器（EEPROM）

模拟前端电路完成非接触接口数据的解调和回发，为整个芯片提供稳定的时钟，完成双界面电源管理，完成接触界面的数据输入和输出。

数字逻辑电路完成非接触协议的处理和双界面数据的交互，并控制 EEPROM 的读写操作。

EEPROM 提供高可靠的数据存储。

### 3.2 存储器

#### 3.2.1 概述

芯片内置 8Kbits 的 EEPROM 存储器，存储空间可由非接触和接触两个界面分别访问。

#### 3.2.2 组织结构

##### 3.2.2.1 非接触界面

可通过非接触界面访问芯片内部的 EEPROM 存储器。

EEPROM 以 4 字节为 1 个 Block 来组织，READ 和 WRITE 均以 Block 地址作为最小寻址单位，READ 指令中的地址为读取的起始地址，依次读出 4 个 Block 的数据。WRITE 指令每次写入当前地址对应的 Block。

扣除制造商信息区和配置信息区后，用户可以使用的数据空间为 Block 04h~E1h，总计 222 Blocks，即 888 字节。E2h 存储 Dynamic Lock Bytes。E3h~FBh 为芯片配置信息区，FCh~FFh 为制造商信息区。

整体空间划分示意图如下：

RF Block Num		Byte Number			
DEC	HEX	+0	+1	+2	+3
0	00h	Serial Number			
1	01h	Serial Number			
2	02h	Serial Number	internal	RF Lock Byte(part1)	
3	03h	Capability Container(CC)			
4	04h	User Data Area (222 Blocks 888Bytes)			
5	05h				
...	...				
225	E1h				
226	E2h	RF Lock Bytes(part2)			
227	E3h	RFU			AUTH0
228	E4h	USER_CFG0	USER_CFG1	USER_CFG2	USER CFG CHK WORD
229	E5h	RFU			
230	E6h				
231	E7h				
232	E8h	AUTH PICC KEY byte0~byte3			
233	E9h	AUTH PICC KEY byte4~byte7			
234	EAh	AUTH PICC KEY byte8~byte9		RFU	
235	EBh	RFU			
236	ECh				
237	EDh				
...	...				
251	FBh				
252	FCh	Manufacture DATA			
253	FDh				
254	FEh				
255	FFh				

图 3-1 非接触接口 EEPROM 存储空间分配

### 3.2.2.2 接触界面

可通过接触接口（I2C）访问芯片内置的 EEPROM 存储器。

接触接口对 EEPROM 的访问以 16byte 为 1 个 Page 来组织。用户数据区、配置数据区和制造商数据区所在的字节地址与非接触界面完全一样，只是接触接口可以一次向 EEPROM 写入一个 Page（16Byte）数据（最多写满一页，页内地址 0x0~0xF）。

接触接口写 EEPROM 时采用 Page 内地址绕回策略，一次写操作无法跨越单 Page 范围，当写入地址达到 Page 边界时，后续写入将绕回到 Page 起始地址。例如：假设接触口写 EEPROM 起始地址位于 Page 内地址 0xF，连续写入 2 字节，实际 EEPROM 被依次写入的是当前 Page 的 0xF 和 0x0 地址。

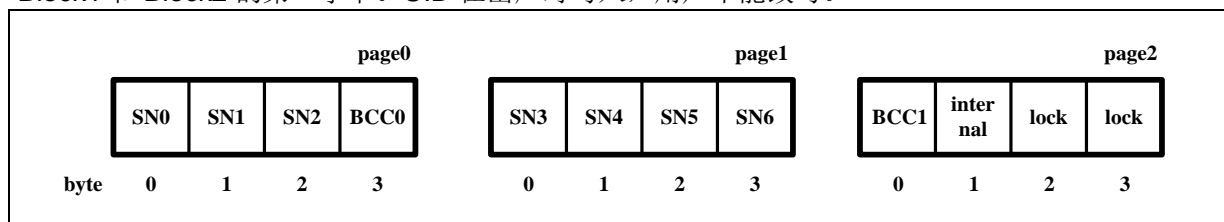
接触接口可以访问大部分 EEPROM 空间，权限受 CT Lock Bits 控制。

EE Page Num	EE Byte Num	I2C Start Addr	Byte Number			
DEC	HEX	HEX	+0	+1	+2	+3
0	0h	000h	Serial Number			
	4h	004h	Serial Number			
	8h	008h	Serial Number	internal	RF Lock Byte(part1)	
	Ch	00Ch	Capability Container(CC)			
1~57	10h	010h	User Data Area (222 Blocks 888Bytes)			
	14h	014h				
	...	...				
	384h	384h	RFU			
	388h	388h				
	38Ch	38Ch				
	390h	390h	USER_CFG0	USER_CFG1	USER_CFG2	USER CFG CHK WORD
	394h	394h	RFU			
	398h	398h				
	39Ch	39Ch				
58	3A0h	3A0h	AUTH PICC KEY byte0~byte3			
	3A4h	3A4h	AUTH PICC KEY byte4~byte7			
	3A8h	3A8h	AUTH PICC KEY byte8~byte9		RFU	
	3ACh	3ACh	RFU			
59	3B0h	3B0h	RFU		VOUT_RES_CFG	I2C Addr
	3B4h	3B4h	RFU			
	3B8h	3B8h	RFU			
	3BCh	3BCh	ATQA		SAK1	SAK2
60	3C0h	3C0h	CT Lock Bytes			
	3C4h	3C4h				
	3C8h	3C8h	RF Dynamic Lock Bytes		RFU	
	3CCh	3CCh	RFU			AUTH0
61~62	3D0h	3D0h	RFU			
	3D4h	3D4h				
	...	...				
	3ECh	3ECh				
63	3F0h	3F0h	Manufacture DATA			
	3F4h	3F4h				
	3F8h	3F8h				
	3FCh	3FCh				

图 3-2 接触接口 EEPROM 存储空间分配

### 3.2.3 UID/Serial Number

每颗芯片独有的 7 字节序列号(UID)及其 2 字节校验码存放在 EEPROM 的最低地址,包括 Block0、Block1 和 Block2 的第一字节。UID 在出厂时写入,用户不能改写。



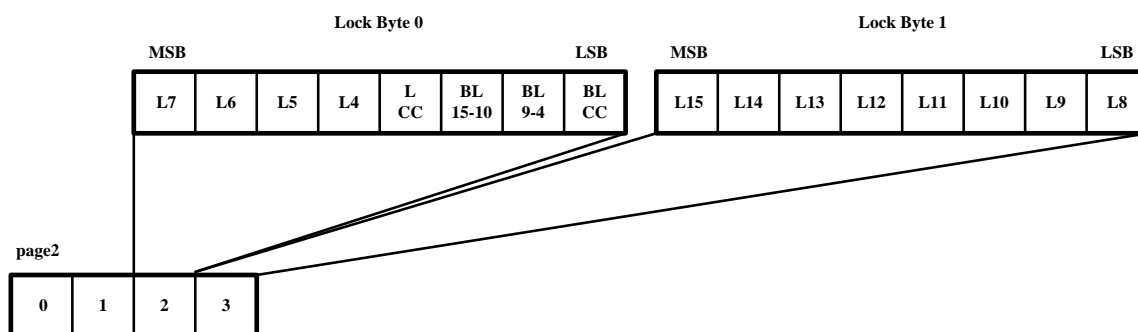
根据 ISO14443-3 校验字节 BCC0 定义为  $CT \oplus SN0 \oplus SN1 \oplus SN2$ , 而 BCC1 定义为  $SN3 \oplus SN4 \oplus SN5 \oplus SN6$ 。

SN0 保存复旦微电子公司的制造商代码 1D。

### 3.2.4 CL Static Lock Bytes

Block2 的 byte2 和 byte3 为 static lock bytes, 可用于锁定 static data area 中的 12 页和 CC 页的写权限。Static lock bits 为 OTP 属性, 用户一旦将其改写为 1, 便无法再改写为 0, 同时对应 Bit7~Bit4 变为只读属性, 无法改写。

Lock byte0 的 Bit7~Bit4 和 lock byte1 的 Bit7~Bit0 分别对应锁定 12 个 static data page, lock byte0 的 Bit3 对应 CC 页, lock byte0 的 Bit2~Bit0 则为 Block-Locking Bits (BL), BL 位一旦置为 1, 则对应的 lock 位不能再改写。



上图中, Lx 表示用于锁定 Page x 的写权限, BLx 表示阻止改写 memory area x 的 BL 位。

例如, 若 BL15-10 被置位成 1, 则 L15~L10 (lock byte1 的 Bit[7:2]) 将不能再被改写。所有的 Lx 和 BLx 都是 OTP, 用户可以用 WRITE 命令进行改写, 一旦写为 1, 不能再改写为 0, 且具有抗撕裂能力。

对于 NTCI 产品子型号, 出厂时 Static Lock bytes 的默认值为 FFFFh。

对于 NTCZ 产品子型号, 出厂时 Static Lock bytes 的默认值为 0000h, 如需锁定, 用户需从非接触端将 Lock Bytes 更改为 FFFFh。

### 3.2.5 CL Dynamic Lock Bytes

根据 NFC FORUM T2TOP 规范, Dynamic lock bytes 用来锁定从 Page 10h 开始的用户存储器区

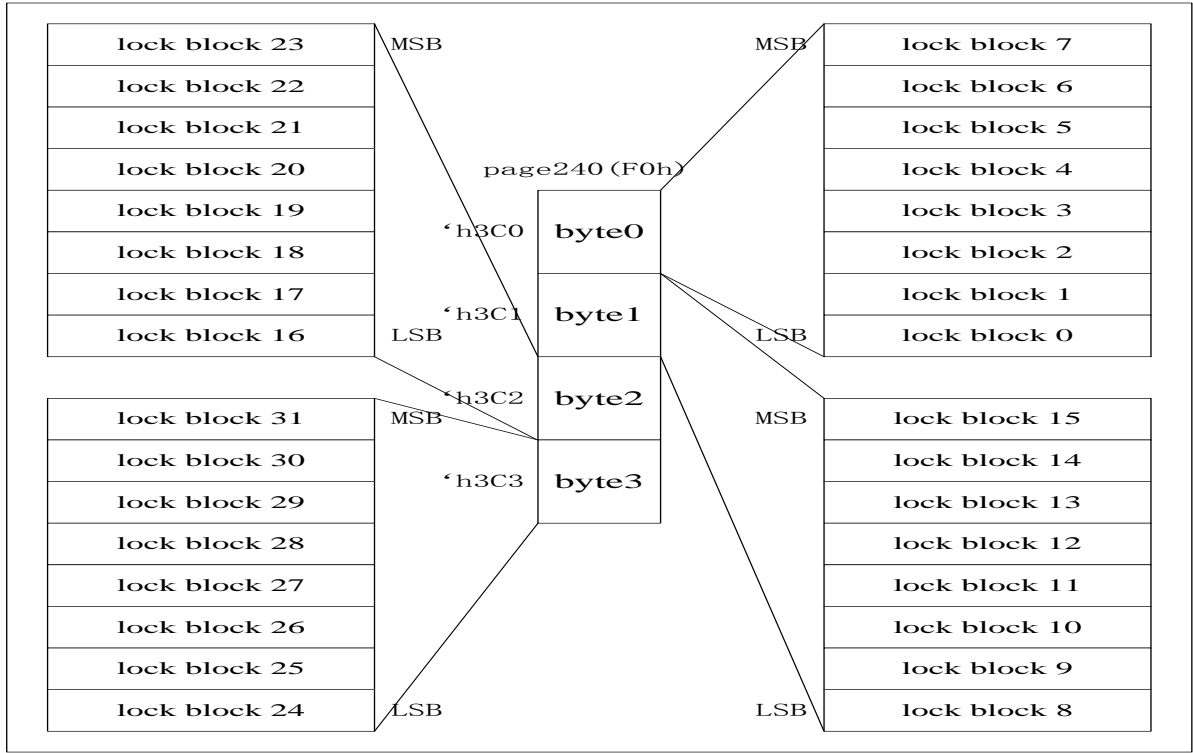


域。

Dynamic Lock Bytes 页地址	页锁定范围
E2h	16~225

Dynamic Lock bytes 同样具有 OTP 属性，一旦被置为 1，不能再被改写为 0。

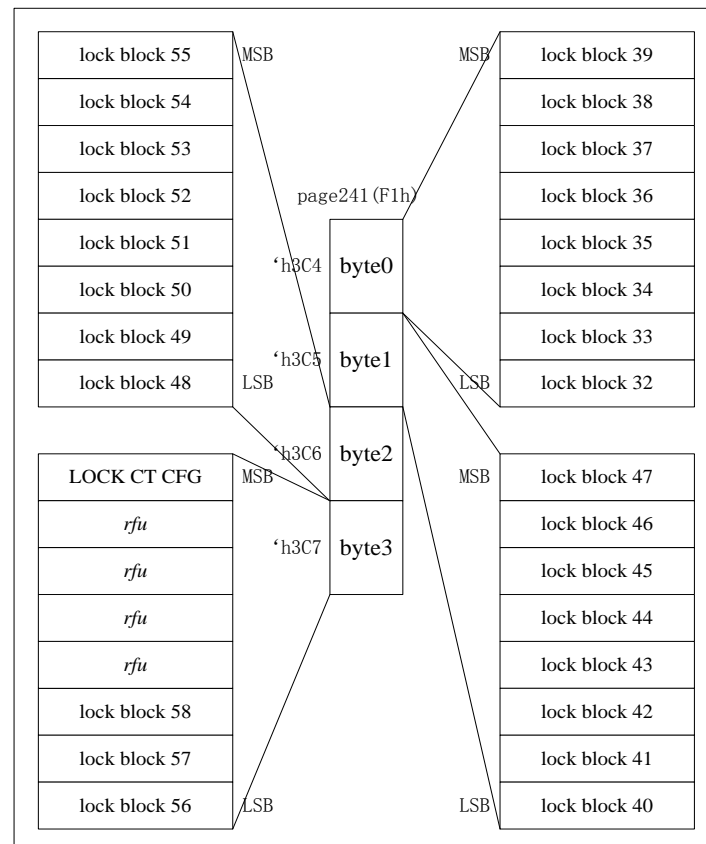
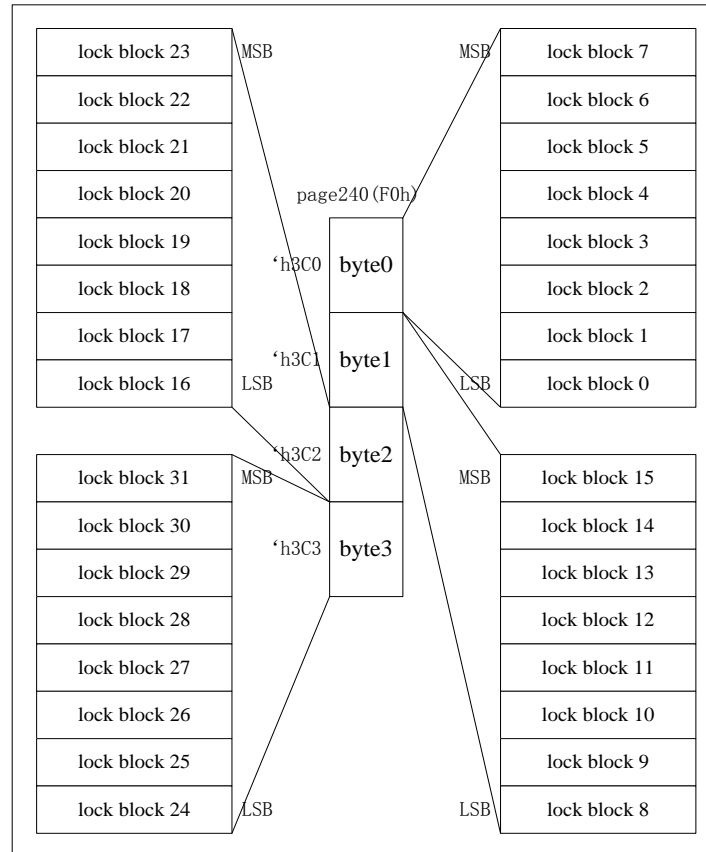
Dynamic Lock bytes 定义：



3.2.6 CT Lock Bits

为了避免接触接口对 EEPROM 内容的误改写，可以通过 CT Lock Bits 将特定地址的 EEPROM 置于写保护的状态下，相应的 EEPROM 存储单元一旦被写保护就不能再被改写。CT Lock Bits 位于 EEPROM 特定位置，且实现为 OTP（One-Time-Programmable），因此 CT Lock Bits 中的位一旦被改写为 1，将不能再改写成 0，也即 EEPROM 对应地址空间一旦被锁定将不能再解锁。

CT Lock Bits 固定位于 EEPROM 的第 F0h 和 F1h Block（4Bytes per Block），每 Bit 用来锁定一个 Page（16Bytes per Page），Lock Bits 的分配关系如下图所示：



关于接触接口锁定位需要注意以下几点：

上海复旦微电子集团股份有限公司  
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

**FM11NT082C**

**NFC 双界面标签及通道芯片**



- 芯片的 EEPROM 共包含 64 Pages
- Page 0~59 受 lock bites 控制，每 bit 控制 16byte 写权限
- Page 61~62 为 RFU，接触接口可直接读写，Page63 为制造商信息区，用户无法改写
- Page 60 为 CT Lock Bits 所在 Page，OTP 属性
- CT Lock Bits 只能由接触接口改写，非接触接口无法改写
- CT Lock Bits 的写保护功能只对接触接口访问有效

### 3.2.7 AUTH KEY

芯片与读写器间进行安全认证所需要的密钥，位于 E8h/E9h/EAh 三个 page 中，共 10byte。接触接口不可修改，非接触接口认证通过后可修改。

### 3.2.8 AUTH0

AUTH0 位于 page E1h byte3。且有 OTP 属性。用于定义需要密码算法保护的安全数据区的起始页地址。

AUTH0 定义了用户数据区内受保护区域的起始地址。用户数据区范围为 Block 0x00~Block 0xE1。其中：

- Block 0x00~Block 0x03 不受 AUTH0 地址保护。
- 从 AUTH0 定义的 Block 开始到 Block 0xE1，受到算法认证保护。
- 如果 AUTH0 = 0x00 或者 AUTH0 > 0xE1，那么全部用户数据区不受算法保护。
- 如果 AUTH0 < 0x04，那么受保护起始地址为 0x04。

AUTH0 在全 0 时可写，一旦非 0 就不能再修改。用户需要谨慎修改。

### 3.2.9 USER CFG

Block E4h 存储用户的配置数据。其中 byte0~2 为具体配置，byte3 为校验位。当  $\text{byte3} = \sim(\text{byte2} \wedge \text{byte1} \wedge \text{byte0})$  时，相关配置有效，否则芯片使用默认配置。

USER CFG 的详细配置说明见对应寄存器。

需要特别注意的是，配置中的 RFU 位必须为 0，否则会影响校验结果。

### 3.2.10 Capability Container

Capability Container 根据 NFC Forum Type2 Tag 规范生成。CC 页内容的详细定义可以参考 NFC Forum T2TOP1.1。CC 字节的内容可以通过 WRITE 指令改写，CC 具有 OTP 属性，一旦置为 1，不能再改写为 0。

为了保证对 NFC T2TOP 的兼容性，不建议用户修改 CC 的内容。

CC 的详细定义如下：

- Byte0: 必须为 E1h 以符合 NFC Forum 要求
- Byte1: 代表芯片支持的 NFCT2T OP 版本号，比如 10h 表示 version1.0
- Byte2: 此字节×8 代表 data area 大小，比如 06h 表示 Tag 数据区为 48 字节
- Byte3: 高 4bit 表示 CC 和 data area 的读权限，默认 0h，8h-Eh 为私有化数据，1h-7h 和 Fh

为 RFU；低 4bit 表示 CC 和 data area 的写权限，默认 0h，Fh 表示禁止写权限

### 3.2.11 CC 区出厂初始化

CC Block (03h) 在芯片出厂时已经根据 NFC Forum T2TOP 规范预先进行数据初始化。04h 以后的用户区初始化数据为全“00h”。

所有用户区对应的 LOCK 位在出厂时为“0”状态，意味着所有的页都处于未锁定状态。

页地址	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3
03h	E1h	10h	6Dh	00h

### 3.2.12 双界面访问权限仲裁

NT082C 芯片具有 I2C 管脚，可与外部 MCU 进行通讯。

若接触接口 (I2C) 和非接触接口 (NFC) 都有效，则都可以读写 EEPROM，存在双界面同时访问 EEPROM 导致冲突的可能性，芯片提供以下仲裁机制：

- 先到先得
  - 一个接口收到有效指令，正在工作时，另外一个接口需等待，此时另一接口被复位。
- 接触接口优先
  - 接触接口可打断非接触接口正在进行的除擦写 EEPROM 以外的任意操作。
  - 如非接触接口正在擦写 EEPROM，接触接口发来的任意有效指令都会使仲裁冲突标志 arbitration\_flag 置位。
  - 非接触接口正在做除擦写 EEPROM 以外的操作时，接触接口发来的任意有效指令都会强行复位非接触接口。
- 非接触接口优先
  - 非接触接口可打断接触接口正在进行的除擦写 EEPROM 以外的任意操作。
  - 非接触接口工作时，会复位接触接口。
- 无优先级
  - 一个接口工作时，另一个接口不会复位，因此在此模式下，EEPROM 可作为数据缓存使用，完成两个接口之间的实时的数据交互，详见相关应用文档。
  - 如果两个接口同时读 EEPROM 或读写寄存器，会存在地址冲突，此种情况需通过协调双界面操作进行规避；
  - 如果一个接口正在擦写 EEPROM，则另一接口无法读或写 EEPROM，需等待擦写完成。
  - 如非接触接口正在擦写 EEPROM，接触接口发来的任意有效指令都会使仲裁冲突标志 arbitration\_flag 置位。

## 3.3 寄存器

### 3.3.1 概述

芯片的寄存器是指非接触、接触接口可以直接访问的控制和配置寄存器。

### 3.3.2 系统寄存器列表

系统寄存器的地址空间是 FFDFh~FFEFh，地址分配如表 3-1 所示。各寄存器的具体定义参见相关功能模块章节。

CL 地址	I2C 地址	名称	功能
0xE0	0xFFE0	USER_CFG0	用户功能配置寄存器
0xE1	0xFFE1	USER_CFG1	用户功能配置寄存器
0xE2	0xFFE2	USER_CFG2	用户功能配置寄存器
0xE6	0xFFE6	RESET_SILENCE	复位和静默寄存器
0xE7	0xFFE7	STATUS	芯片状态标志寄存器
0xE9	0xFFE9	VOUT_EN_CFG	场能量对外供电使能寄存器
0xEA	0xFFEA	VOUT_RES_CFG	对外供电内阻配置寄存器

表 3-1 非接/接触接口寄存器地址

### 3.3.3 系统寄存器详细定义

#### 3.3.3.1 符号与规则

Name	:	寄存器名称
Address	:	寄存器地址（分别列出 CL、I2C 地址）
Field	:	位域
Description	:	功能描述
Default	:	复位值
Access	:	接触口访问权限
R	:	可读
W	:	可写
W <sub>AUTH</sub>	:	认证后可写
RW	:	可读可写
Dy	:	硬件动态置位
RC	:	总线读清零
PCD	:	非接触读卡设备（proximity coupling device）
MCU	:	与本芯片接触接口相连的外部主控 MCU
CT	:	接触接口
CL	:	非接触接口
REG	:	register, 寄存器

#### 3.3.3.2 USER\_CFG0

用户配置寄存器
Applicable Interface: CL/I2C

REG Address: E0/FFE0			
EEPROM Block Address: E4			
Field	Description	Default	Access
7:6	Vout_mode, 配置 VOUT 引脚对外供电的工作模式 0x: VOUT 不对外供电 10: 上电即开始对外供电 11: 是否对外供电受寄存器 VOUT_EN_CFG 控制	2'b10	RW
5	demodu_enhancement: 解调增强功能, 用于大功率读写器 0: 不开启解调增强功能 1: 开启解调增强功能	1'b0	RW
4:3	RFU	2'b00	RW
2	RFU	1'b0	RW
1	RFU	1'b0	RW
0	RFU	1'b0	-

### 3.3.3.3 USER\_CFG1

用户配置寄存器			
Applicable Interface: CL/I2C			
REG Address: E1/FFE1			
EEPROM Block Address: E4			
Field	Description	Default	Access
7	rf_inventory_en 0: 非接触接口不支持快速防冲突功能 1: 非接触接口支持快速防冲突功能	1'b1	RW
6	fdt_comp_en 0: FDT 补偿功能关闭 1: FDT 补偿功能开启	1'b0	RW
5:4	fdel, FDT 补偿选择 00: 2/fc 01: 4/fc 10: 6/fc 11: 8/fc	2'b00	RW

3:0	RFU	4'hc	-
-----	-----	------	---

### 3.3.3.4 USER\_CFG2

用户配置寄存器			
Applicable Interface: CL/I2C			
REG Address: E2/FFE2			
EEPROM Block Address: E4h byte2			
Field	Description	Default	Access
7:6	RFU	2'b00	RW
5:4	arbitration_cfg, 仲裁模式选择 00: 无优先级 01: 先到先得 10: CT (接触端) 优先 11: CL (非接触端) 优先	2'b10	RW
3:0	ct_sleep_cfg[3:0], 配置 CT 接口空闲后多久时间进 sleep 状态 4'h0: 0.5ms 4'h1: 1ms 4'h2: 2ms 4'h3: 4ms 4'h4: 8ms 4'h5: 16ms 4'h6: 32ms 4'h7: 64ms 4'h8~f: 持续上电, 芯片不进入 sleep 状态	4'h1	RW

### 3.3.3.5 RESET\_SILENCE

软件复位寄存器			
Applicable Interface: I2C			
REG Address: FFE6			
Field	Description	Default	Access
7:2	RFU	-	-

1	<b>soft_rst</b> 向此寄存器写 8'h55, 芯片回发结束后, 触发芯片复位。复位完成后此寄存器自动清零	1'b0	W
0	<b>cl_silence</b> 1: 向此寄存器写 8'h33, cl_silence 置 1, 非接触接口复位, 芯片进入非接触接口静默状态 0: 向此寄存器写 8'hCC, cl_silence 清 0, 非接触接口复位放开, 芯片脱离静默状态	1'b0	RW

### 3.3.3.6 STATUS

系统状态标志寄存器			
Applicable Interface: CL/I2C			
REG Address: E7/FFE7			
Field	Description	Default	Access
7:1	RFU	-	-
0	<b>user_cfg_chk_flag</b> , 标志上电时从 EEPROM 的 E4h block 中读出的 user_cfg 配置的校验结果, 若校验失败, 则使用出厂默认值 0: 校验成功 1: 校验失败	1'b0	R

### 3.3.3.7 VOUT\_EN\_CFG

场能量对外供电使能			
Applicable Interface: CL/I2C			
REG Address: E9			
Field	Description	Default	Access
7	<b>vout_en</b> , 当寄存器 USER_CFG0.vout_mode=2'b11 时, 芯片是否对外供电受本寄存器控制, 否则本寄存器无效 0: 关闭对外供电 1: 开启对外供电	1'b0	RW
6:0	RFU	-	-

### 3.3.3.8 VOUT\_RES\_CFG

模拟配置寄存器			
---------	--	--	--

Applicable Interface: CL/I2C

REG Address: EA

EEPROM Block Address: ECh byte2

Field	Description	Default	Access
7:4	vout_res_cfg, 配置对外供电时限流电阻阻抗	4'b1000	RW
3:0	RFU	4'b0000	-

## 3.4 电源管理

### 3.4.1 概述

芯片电源管理方案的主要特点:

- 双界面电源自动切换, 内核单电源工作。
- 可收集射频场能量对片外进行供电。
- 多种电源开关的控制方式

### 3.4.2 电源方案

下图是芯片的电源方案。VCC 为接触端口电源, 通过开关 Switch 与非接触端的整流输出合并为内核主电源, 并输出到片外。

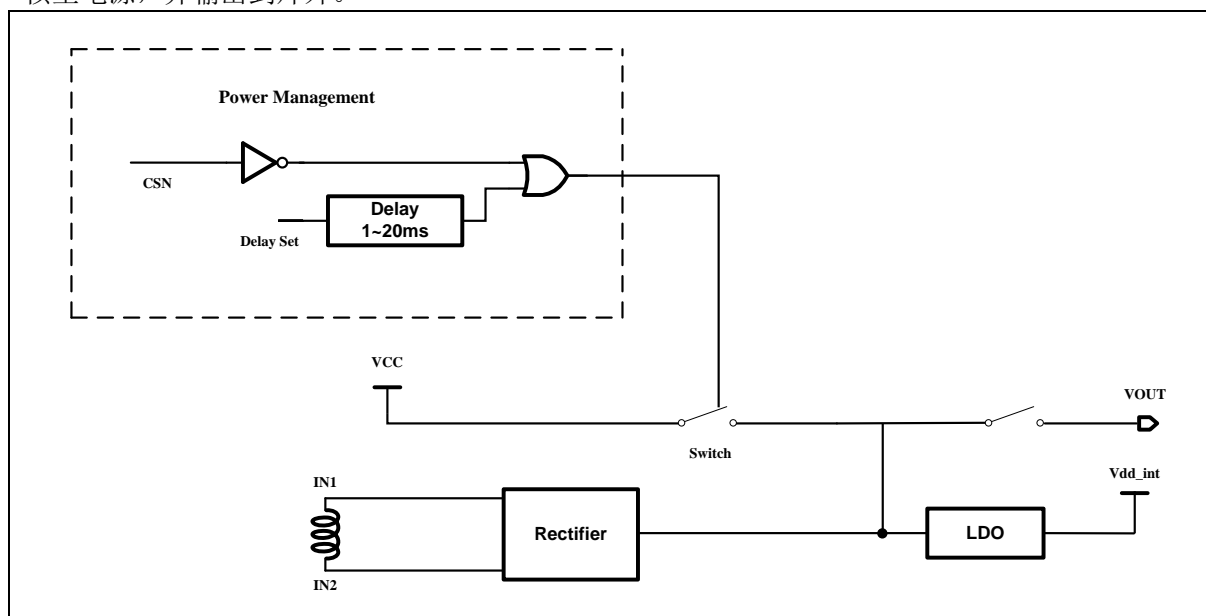


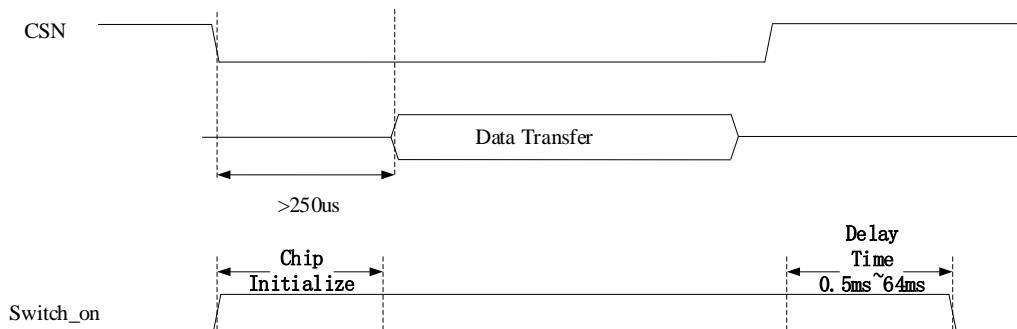
图 3-3 芯片电源方案

在接触端有数据通讯时, 接触端电源通过开关给芯片供电; 当接触端无数据通讯时, 接触端开关断开, 使接触端实现零功耗待机模式。

1. 电源开关操作方式:



(1) MCU 在发送数据前, 将 CSN 管脚信号拉低, 需要延迟 250us, CSN 管脚拉高以后, 延迟 Delay Time 时间后, 开关关闭。Delay Time 时间长度可在 USER\_CFG2 中的 ct\_sleep\_cfg[3:0] 中配置, 范围为 0.5ms~64ms, 或配置为永久上电。



(2) 配置延迟时间的长度, 取决于 MCU 发出的两条 I2C 指令之间的最大间隔。如果芯片接收到的是擦写 EEPROM 的指令, 在擦写期间, 电源开关自动处于打开状态, 擦写结束以后, 芯片再延迟 Delay Time 后关闭电源开关。Delay Time 的定时从擦写 EEPROM 结束后开始计算。

2. 接触端零功耗待机:

VCC 下的电路在开关关闭的情况下无直流通路, 实现了零功耗待机模式。

3. 场能量对外供电芯片支持将场能量整流稳压后通过 VOUT 管脚输出, 为外部其他电路供电, 具体描述参见 4.6 场能量对外供电章节。

## 3.5 安全认证

### 3.5.1 安全算法

芯片支持采用安全算法进行权限校验的功能。

关于算法的使用说明、算法的实现细节及相关程序, 请咨询复旦微电子, 获取更多的资料。

芯片的算法认证功能应用于以下场景:

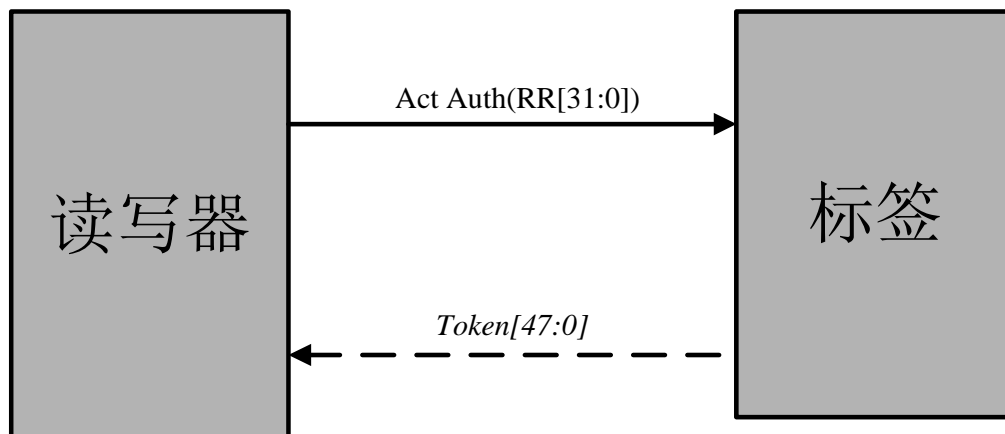
- 用于控制通过非接触接口访问 EEPROM 中的安全数据区的权限;
- 用于控制通过非接触接口改写 USER\_CFG (EEPROM 中的 Block E4h) 的权限;

### 3.5.2 下行安全认证

芯片内置安全算法, 可使用 ACT\_AUTH 指令完成读写器对标签芯片的单向认证, 用以验证芯片的真伪, 从而完成芯片所附属的电子产品的原厂溯源认证。

下行认证流程如下:





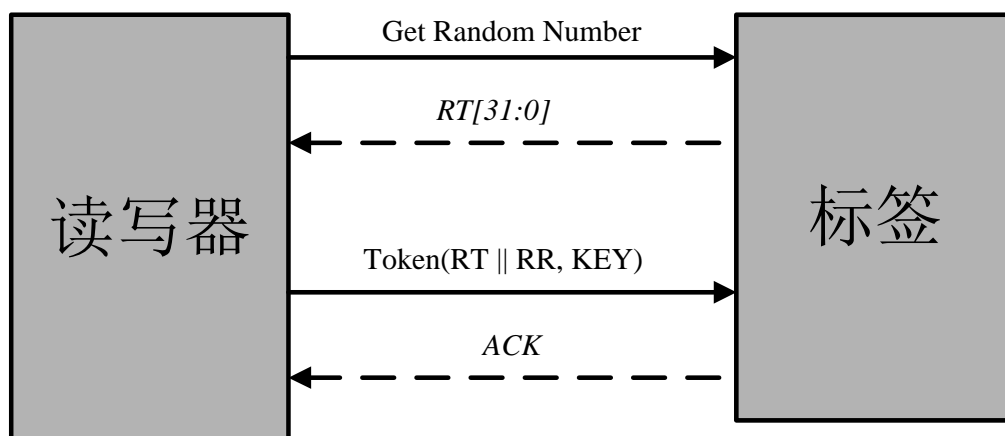
其中:  $\text{Token} = \text{Enc}(\text{RT} \parallel \text{RR}, \text{KEY})$

1. 读写器生成一个 32bits 随机数 RR，然后向标签发送 Act Auth 指令，发起读写器对标签的单向认证申请。32bits 随机数 RR 作为 Act Auth 指令的参数下发给标签。
2. 标签收到 Act Auth 指令后，内部生成一个 16bits 随机数 RT。标签使用事先和读写器约定好的认证密钥 (Key) 对数据 RT || RR 加密，得到 48bits 密文  $\text{Token} = \text{Enc}(\text{RT} \parallel \text{RR}, \text{KEY})$ 。标签将 Token 返回给读写器。
3. 读写器收到标签返回的 Token 后，根据加密算法逆向算出 (RT || RR')。比较 RR' 与 RR 是否相同。如果相同，则读写器认为标签身份合法。如果不同，则读写器认为标签身份非法。通常读写器或手机只作为通道，运算和确认过程在云端进行。

### 3.5.3 上行安全认证

上行安全认证是标签对读写器的认证，认证完成后，可赋予改写某些寄存器或访问某些 EEPROM 存储区的权限，通过改写寄存器，可以实现一些权限的解除锁定或一些管脚的翻转动作；某些 EEPROM 存储区内可存储敏感数据，通过对这些存储区的访问权限控制，可实现敏感数据的读取保护。

上行认证流程如下：



其中:  $\text{Token} = \text{Enc}(\text{RT} \parallel \text{RR}, \text{KEY})$

1. 读写器发送获取随机数指令 REQ AUTH，标签生成一个 32bits 随机数 RT，回发给读写器。
2. 读写器收到标签的随机数 RT 后，内部生成一个 16bits 随机数 RR，并使用事先和标签约定好的认证密钥（Key）对数据 RT || RR 加密，得到 48bits 密文 Token= Enc(RT || RR, KEY)。读写器用 AUTH 指令将加密结果 Token 发给标签。
3. 标签收到读写器发来的 Token 后，根据加密算法逆向算出(RT' || RR)。比较 RT'与 RT 是否相同。如果相同，则标签认为读写器身份合法。如果不同，则标签认为读写器身份非法。

## 3.6 非接触接口

### 3.6.1 概述

芯片支持的指令集如下表所示：

Command	Code	Description
Request	26h	
WakeUp	52h	
Anticollision CL1	93h 20h	
Select CL1	93h 70h	
Anticollision CL2	95h 20h	
Select CL2	95h 70h	
Halt	50h 00h	
READ	30h	读 EEPROM
WRITE	A2h	写 EEPROM
READ_REG	1Ch	读寄存器
WRITE_REG	1Dh	写寄存器
REQ_AUTH	B0h	从芯片获取 32bit 随机数
AUTH	B1h	用于芯片对读写器认证
ACT_AUTH	B2h	用于读写器对芯片认证

NT082C 定义了 4bit 的 ACK 和 NAK，其编码和含义如下：

Code	ACK/NAK
4'ha	Acknowledge
4'h0	NAK，命令参数错误
4'h1	NAK，校验位或 CRC 错

### 3.6.2 指令格式及简要说明

#### 3.6.2.1 REQA

指令格式如下：

SOF	CMD	EOF
	7bits	
	0x26	

回发如下：

SOF	ATQA	EOF
	2bytes	
	0044	

### 3.6.2.2 WUPA

指令格式如下：

SOF	CMD	EOF
	7bits	
	0x52	

回发如下：

SOF	ATQA	EOF
	2bytes	
	0044	

### 3.6.2.3 ANTICOLLISION

指令格式如下：

SOF	CMD	NVB	UID	EOF
	1byte	1byte	N bits	
	0x93 0x95		具体 UID 的 bit 数由 NVB 数值决定	

回发如下：

SOF	UID	EOF
	40-n bits	

### 3.6.2.4 SELECT

指令格式如下：

SOF	CMD	NVB	UID	CRC16	EOF
	1byte	1byte	5bytes	2bytes	
	0x93 0x95	0x70			

回发如下：

SOF	SAK	CRC16	EOF
	1byte	2bytes	



--	--	--	--

3.6.2.5 HLTA

指令格式如下：

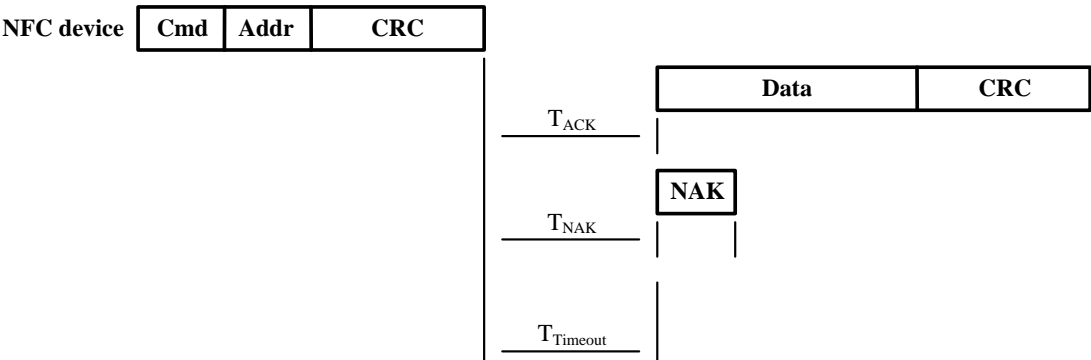
SOF	CMD	PARA	CRC16	EOF
	1byte	1byte	2bytes	
	0x50	0x00		

此指令无回发。

3.6.2.6 READ

READ 命令只有一个字节的参数——读地址(Page Address)，最多寻址 256 页，每页占 4 字节，共计 1KB。

NT082C 在收到 READ 命令后，在规定时间内回发页地址参数指定页开始的 16 个字节（固定回发 4 页），或者回发 NAK 响应。



内容	编码	描述	长度
Cmd	30h	READ 命令编码	1byte
Addr	-	读取页起始地址	1byte
CRC	-	CRC 校验码	2bytes
Data	-	NT082C 回发的数据	16bytes
NAK			4bits

比如如果 Addr=03h，则 NT082C 回发 Block 03、04、05、06 的数据。如果 Addr 位于 EE 可访问空间之外，NT082C 回发 NAK。如果 Addr 临近可访问 EE 的边界，则 NT082C 采用 roll-over 策略。比如：若 Addr=F9h，则 NT082C 回发 PageF9、FA、FB、00 的数据；若 Addr>FBh，NT082C 回发 NAK。

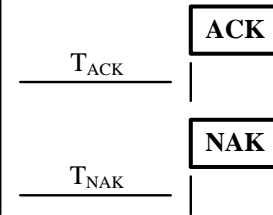
通信的时序特征符合 ISO14443-3 标准。

3.6.2.7 WRITE

WRITE 命令有 2 个参数：写地址（Page Address）和写入数据，写地址与 READ 命令相同，写入数据固定为 4 字节（一个页），LSB 在先。NT082C 擦写 EE 成功后回发 ACK，否则回发 NAK。

NFC device

Cmd	Addr	Data	CRC
-----	------	------	-----



内容	编码	描述	长度
Cmd	A2h	WRITE 命令编码	1byte
Addr	-	写入页地址	1byte
CRC	-	CRC 校验码	2bytes
Data	-	NT082C 收到的数据	4bytes
ACK/NAK			4bits

NT082C 的 WRITE 命令地址有效范围为 00h~FBh，写地址超出地址有效范围将回发 NAK：

### 3.6.2.8 READ REG

指令格式如下：

SOF	CMD	ADDR	CRC16	EOF
	1byte	1byte	2bytes	
	0x3F			

回发如下：

SOF	DATA	CRC16	EOF
	16bytes	2bytes	

READ REGS 命令用于 RF 非接触接口口读取寄存器。ADDR 为起始寄存器地址。

RF 接收到 READ REGS 命令后，在规定时间内回发 ADDR 地址开始的 16 个字节数据。READ REGS 命令不会回发 NAK。

如果寄存器地址不存在，或寄存器不可读，则回发数据被强制设置为全 0。

### 3.6.2.9 WRITE REG

指令格式如下：

SOF	CMD	ADDR	LEN	DATA	CRC16	EOF
	1byte	1byte	1byte	N bytes	2bytes	
	0xAF			N = LEN		

回发如下：

SOF	ACK	CRC16	EOF
	2bytes	2bytes	
	0xAAAA		

WRITE REG 命令用于 RF 非接触接口口写寄存器，有 3 个参数：

a) ADDR 为目标寄存器地址。

b) LEN 为以 Byte 为单位的写数据长度。

c) DATA 为写入数据。DATA 部分长度由 LEN 参数决定，最大支持 16 字节。如果 LEN 为 0，或者大于 16 个字节，那么回发 NAK。Tag 从 ACTIVE 状态跳转到 IDLE 或 HALT 状态。

如果指令参数正确，WRITE REGS 命令会执行写寄存器操作。但是，寄存器写入是否生效收寄存器自身逻辑确定。WRITE REGS 命令不会回发 NAK，都会返回 ACK 标志。

### 3.6.2.10 REQ AUTH

指令格式如下：

SOF	CMD	CRC16	EOF
	1byte	2bytes	
	0xB0		

回发如下：

SOF	RT32	CRC16	EOF
	4bytes	2bytes	

REQ\_AUTH 命令用于读写器向标签申请一个 32bits 随机数 RT32。RT32 主要用于标签对读写器的认证。

读写器收到 RT32 后，自己产生一个 16bits 随机数 RR16。然后将 RT32 和 RR16 拼成一个 48bits 数据，加密后作为 AUTH 指令的 TOKEN 数据发送给标签。

标签接收到 AUTH 指令后，会解密 48bits 数据，并比较解密得到的 RT32'与 RT32 是否一致。如果一致，则标签对读写器的认证通过。否则，标签对读写器的认证失败，并回发 NAK，状态从 ACTIVE 状态跳转到 IDLE 或 HALT 状态。

### 3.6.2.11 AUTH

指令格式如下：

SOF	CMD	TOKEN	CRC16	EOF
	1byte	6bytes	2bytes	
	0xB1			

回发如下：

SOF	ACK/NAK	CRC16	EOF

	2bytes	2bytes	
	ACK: 0xAAAA NAK: 0x0000		

AUTH 命令用于标签对读写器进行身份认证。AUTH 命令只有一个指令参数 TOKEN，长度为 48bits。标签接收到 AUTH 指令后，对 TOKEN 进行解密，并比较解密得到的 RT32' 与 REQ\_AUTH 指令回发的 RT32 是否一致。如果一致，则标签对读写器的认证通过。否则，标签对读写器的认证失败，并回发 NAK，状态从 ACTIVE 状态跳转到 IDLE 或 HALT 状态。

AUTH 指令必须与 REQ\_AUTH 指令配对使用：

- AUTH 指令前必须是一条有效的 REQ\_AUTH 指令。只有这样，AUTH 指令才会正确执行认证功能，认证通过后返回 ACK。
- 如果 AUTH 指令前不是有效的 REQ\_AUTH 指令。那么，标签接收到 AUTH 指令后回发 NAK，状态从 ACTIVE 状态跳转到 IDLE 或 HALT 状态。

AUTH 指令认证通过后，读写器才能访问由 AUTH0 地址保护的数据区。

### 3.6.2.12 ACT AUTH

指令格式如下：

SOF	CMD	RR32	CRC16	EOF
	1byte	4bytes	2bytes	
	0xB2			

回发如下：

SOF	TOKEN	CRC16	EOF
	6bytes	2bytes	

ACT AUTH 命令用于读写器对标签进行身份认证。ACT AUTH 命令带有一个参数 RR32，为读写器下发的一个 32bits 随机数。

标签接收到 ACT AUTH 指令后，自己产生一个 16bits 随机数 RT16。然后将 RR32 和 RT16 拼成一个 48bits 数据，加密后作为 ACT AUTH 指令的回发 TOKEN 数据返回给读写器。

读写器接收到 TOKEN 后，解密并比较 32bits 随机数 RR32' 是否与 RR32 一致。如果一致，则读写器对标签的认证通过。否则，读写器对标签的认证失败。

## 3.7 I<sup>2</sup>C 接口

### 3.7.1 概述

I2C 模块实现芯片与外部带有 I2C 接口的主控 MCU 之间的同步通信，硬件自动实现数据收发和命令解析与处理。通过 I2C 接口，外部主控 MCU 可以直接操作芯片的片内 EEPROM；主控 MCU 还可以通过 I2C 访问片内寄存器。

特点:

- I2C 从机模式
- 7 位从机地址
- 传输速度支持 Standard-mode(100Kbps)、Fast-mode (400Kbps) 和 Fast-mode Plus(1Mbps)
- 读速度受 EEPROM 读出速度限制, 建议传输速度采用 400Kbps

### 3.7.2 I2C 接口上电唤醒

外部主控 MCU 在芯片没有进场的情况下主动发起访问时(读写寄存器或者 EEPROM), 此时芯片处于下电状态, 有三种方式可以使芯片上电工作, 具体见 3.4.2 章节。

### 3.7.3 接口时序

#### 3.7.3.1 接口时序图

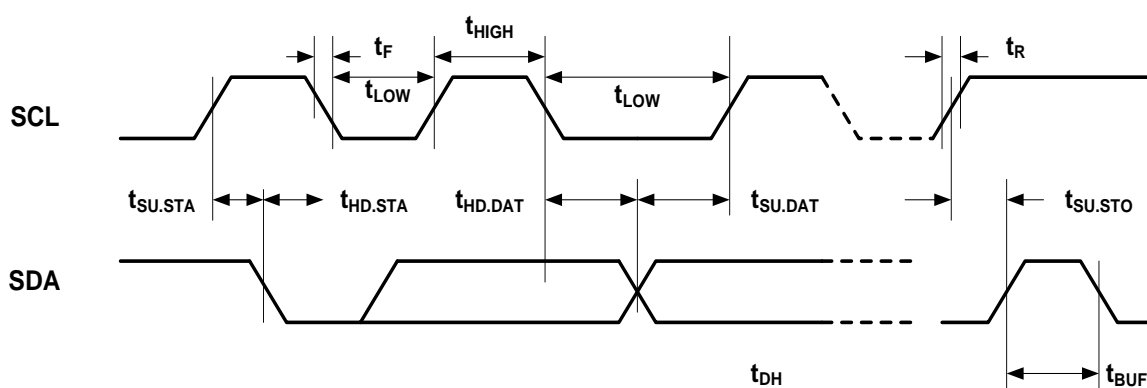


图 3-4 I2C 总线时序

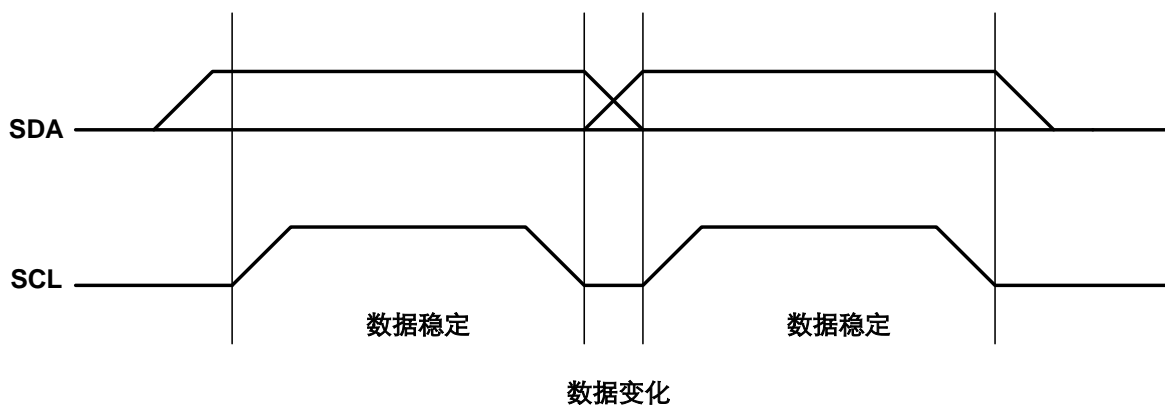


图 3-5 数据有效时序



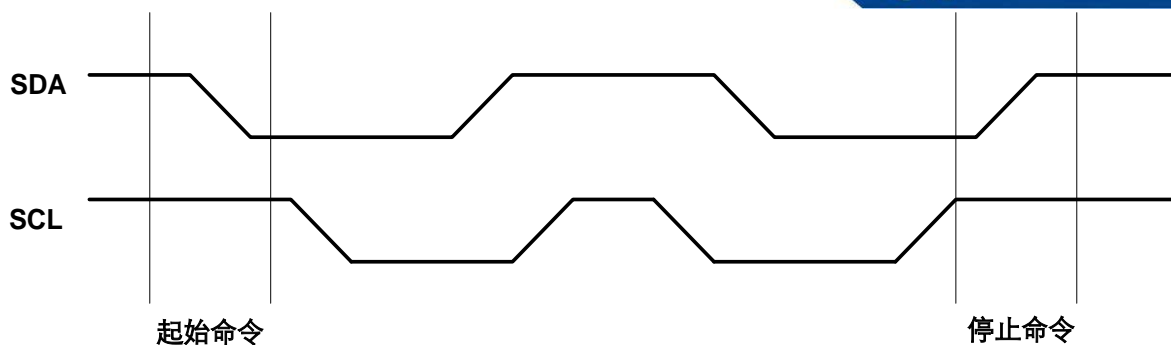


图 3-6 起始 (Start) 与停止(Stop)命令定义

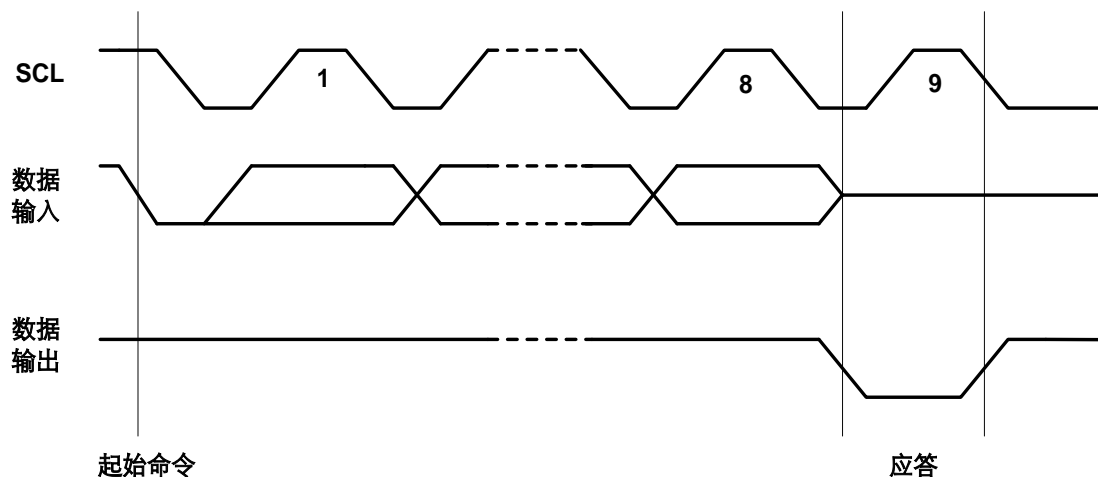


图 3-7 输出应答(ACK)

### 3.7.3.2 接口时序描述

**时钟有效时序:** SDA 引脚通常被外围器件拉高。SDA 引脚的数据应在 SCL 为低时变化(参见图 3-4); 当数据在 SCL 为高时变化, 将视为下文所述的一个起始或停止命令。

**起始命令:** 当 SCL 为高, SDA 由高到低的变化被视为起始命令, 必须以起始命令作为任何一次读/写操作命令的开始(参见图 3-5)。

**停止命令:** 当 SCL 为高, SDA 由低到高的变化被视为停止命令, 在一个读操作后, 停止命令会使 EEPROM 进入等待(参见图 3-6)。

**输出应答:** SDA 上的数据都是以 8 位为一组串行输入和输出的, MSB 先发, 接收方在收完每个字节后应当在第 9 个周期回发一个回应 acknowledge 位(以下简称 ack), ack 的时钟由主机提供。发送方在 ack 期间悬空 SDA, 接收方须将 SDA 拉低, 确保 ack 时钟高电平期间 SDA 为低, 形成有效的 ack 信号(参见图 3-7)。

## 3.7.4 I<sup>2</sup>C 接口工作流程

### 3.7.4.1 设备选中 (Device Select)

I2C Master 通过 7bit addressing 选中 Slave 设备, 芯片定义的 I2C Slave Device Select Code 如下:

I2C 通信首字节	Device Type Identifier				Chip Enable Address			$\overline{RW}$
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0



Device Select Code	可配置，默认 7'b1010_111	$\overline{RW}$
--------------------	--------------------	-----------------

在发送 Start condition 后，主控 MCU 应通过发送 Device Select Code 选中芯片，使芯片的 I2C 控制电路处于激活状态，以响应进一步的命令和数据。从器件地址默认为 7'b1010\_111，用户可根据实际情况，自行更改 I2C 器件地址。

3.7.4.2 访问模式

模式	$\overline{RW}$	字节数	初始化序列
当前地址读	1	1	start condition, device select, $\overline{RW} = 1$
随机地址读	0	1	start condition, device select, $\overline{RW} = 0$ , 写入地址
	1		start repeat, device select, $\overline{RW} = 1$
顺序读	1	$\geq 1$	类似当前地址读和随机地址读
字节写	0	1	start condition, device select, $\overline{RW} = 0$
页写	0	$\leq 16$	start condition, device select, $\overline{RW} = 0$

表 3-2 I2C 接口访问模式

3.7.4.3 主机向从机发送数据

典型的主机向从机发送数据流图如下所示：

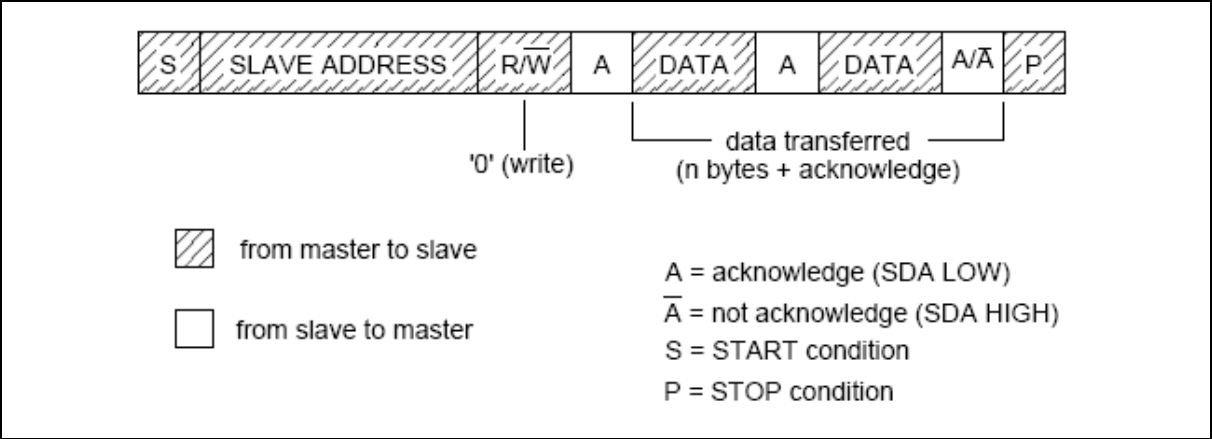


图 3-8 典型的主机向从机发送数据流图

- 1. 主机发起 START 时序
  - 2. 主机发送从机地址，从机地址包含 7 位从机地址和 1 位 R/W 标志位，发送数据时 R/W 位为 0。
  - 3. 主机发送第一帧 8 位数据。
  - 4. 主机在每次发送完 8 位数据后，会在第 9 个 clock 判断是否检测到有效的 ack，如果主机检测到 ack 成功后，会继续输出下一组 8 位的数据。
  - 5. 若从机无法响应 ack，主机检测到 ack 失败后应发送 STOP 时序终止发送。
- 注：从机地址包含 7 位从机地址和 1 位 R/W 标志位

3.7.4.4 主机从从机读取数据

典型的主机从从机读取数据流图如下所示：

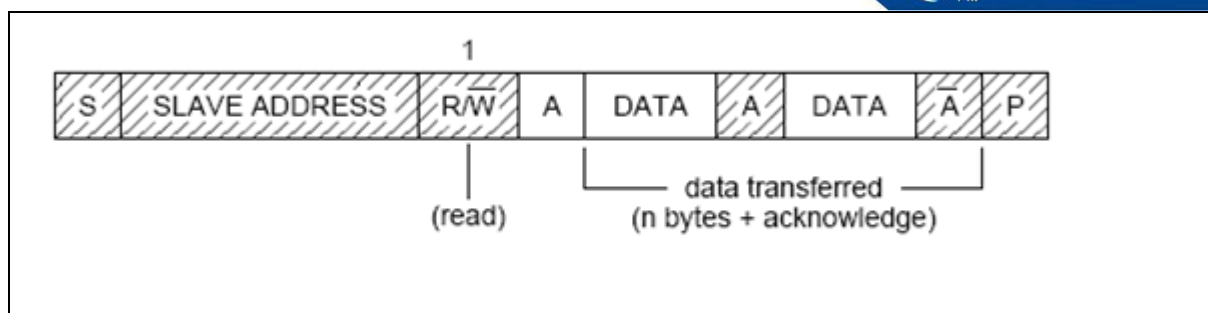


图 3-9 典型的主机从机读取数据流程图

1. 主机发起 START 时序
2. 主机发送从机地址，从机地址包含 7 位从机地址和 1 位 R/W 标志位，数据读取时 R/W 位为 1。
3. 此时设置 SSPCON.RCEN 为 1，主机自动转为接受状态
4. 主机开始接收第一帧 8 位数据，并在第 9 个 clock 向从机发送有效 ack,从而继续读取下一帧 8 位数据。
5. 主机读取结束后，发送 STOP 时序终止读取。

### 3.7.4.5 双向数据读写流程

典型的双向数据读写流程图如下图所示，在主机发送或读取数据过程中，主机可以通过发送 Repeated Start 时序来重新启动一次新的发送或读取通信，所以主机在一次流程中，即可以有数据发送也可以有数据读取。

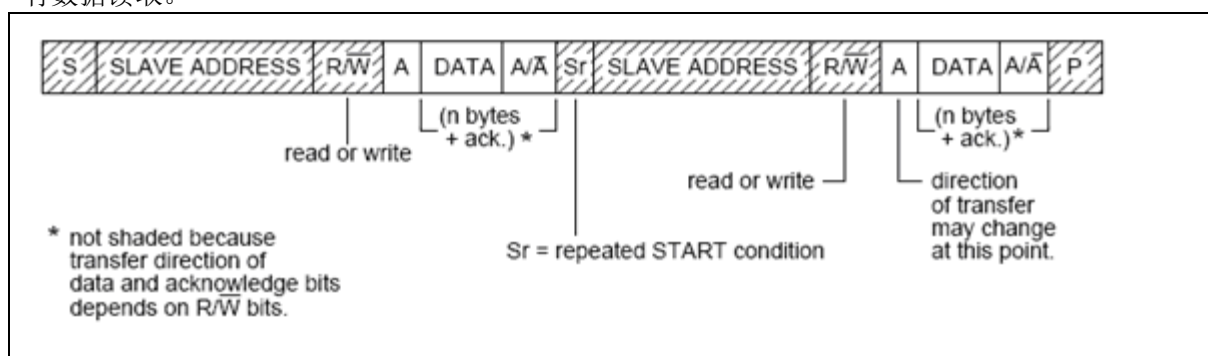
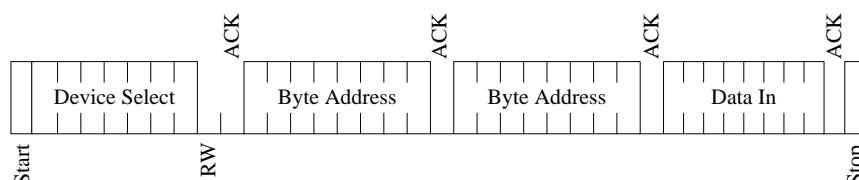


图 3-10 典型的双向数据读写流程图

## 3.7.5 I2C 接口对片内存储器的访问

### 3.7.5.1 写 EEPROM 操作

#### 3.7.5.1.1 字节写



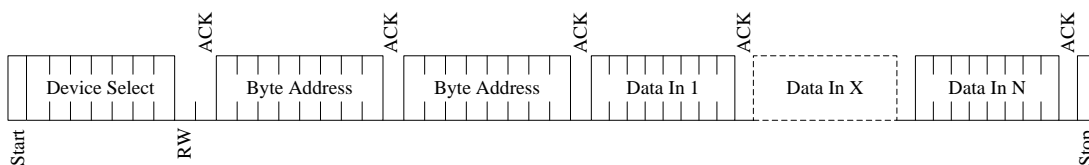
I2C 的字节写的操作序列如上图所示。主控 MCU 先向芯片写入 2 字节目标地址，紧接着发送写入数据，由于总线传输方向没有改变，芯片在更新地址指针后维持写状态，将后续字节写入地址指针指向的位置。

Master 先给出 2 字节 EEPROM 字节地址，寻址范围 0x0000~03FF (1K 字节)，如果字节地址指

向的 EEPROM 的 page 处于被 Lock 的状态，则芯片回发 NACK。

如果目标地址没有被 Lock，当 Master 发送 STOP 后，芯片启动内部擦写 EEPROM 序列，此时擦写 EEPROM 标志置起，保证芯片在擦写过程中持续供电。

### 3.7.5.1.2 页写

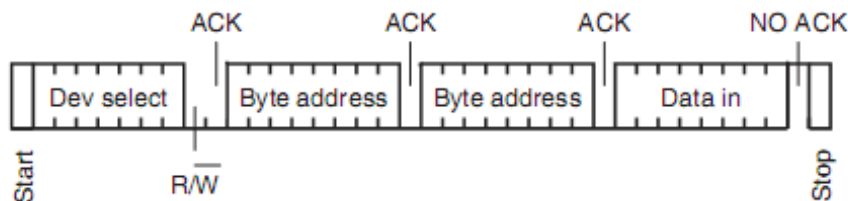


I2C 的页写的操作序列如上图所示。操作方式与字节写相同，MCU 可以连续给出 N 个字节的数据（ $N \leq 16$ ）。

Master 先给出 2 字节 EEPROM 字节地址，寻址范围 0x0000~03FF（1K 字节），如果字节地址指向的 page 处于被 Lock 的状态，则芯片回发 NACK。

如果目标地址没有被 Lock，当 Master 发送 STOP 后，芯片启动内部擦写 EE 序列，此时擦写 EEPROM 标志置起，保证芯片在擦写过程中持续供电。

### 3.7.5.1.3 写被 Lock 的地址



如果 I2C 试图向被 Lock 的地址写入数据，则芯片在收到数据后回发 NACK。

### 3.7.5.1.4 I2C 写 EEPROM 地址范围

按照 EEPROM 的 16 字节物理页划分，8Kbits 共计 64 页，I2C 总线可以擦写的页地址范围是 00h-3Ch。

## 3.7.6 I2C Timeout

在双界面应用下，当芯片的仲裁机制配置为接触端优先或先到先得时，由于 I2C 激活时禁止非接触端访问 EEPROM，为了避免 I2C 总线死机导致非接触端长时间无法工作，芯片的 I2C 接口实现了 timeout 功能。内部使用一个低频时钟工作的计数器，在 I2C 的 START 和 STOP 之间启动计数，并不断检测 SCL 的翻转，一旦检测到 SCL 翻转，就清零计数器，如果超过 20ms 还是没有检测到翻转，则产生复位信号复位整个 I2C 接口电路、接触端口控制电路，并清零仲裁标志位。

## 4 应用指南

### 4.1 总体描述

本章节对接触接口和非接触接口的访问、双界面之间的数据交互以及场能量收集及对外供电功能进行详细描述。

### 4.2 非接触接口通信原理

具体通信协议和时序定义等请用户自行参考 ISO/IEC 14443A 协议。

NT082C 芯片在非接触接口的工作流程如下图所示，芯片接收到 read block0 指令后，直接跳转到 Active 状态，如此可实现广播写入操作。

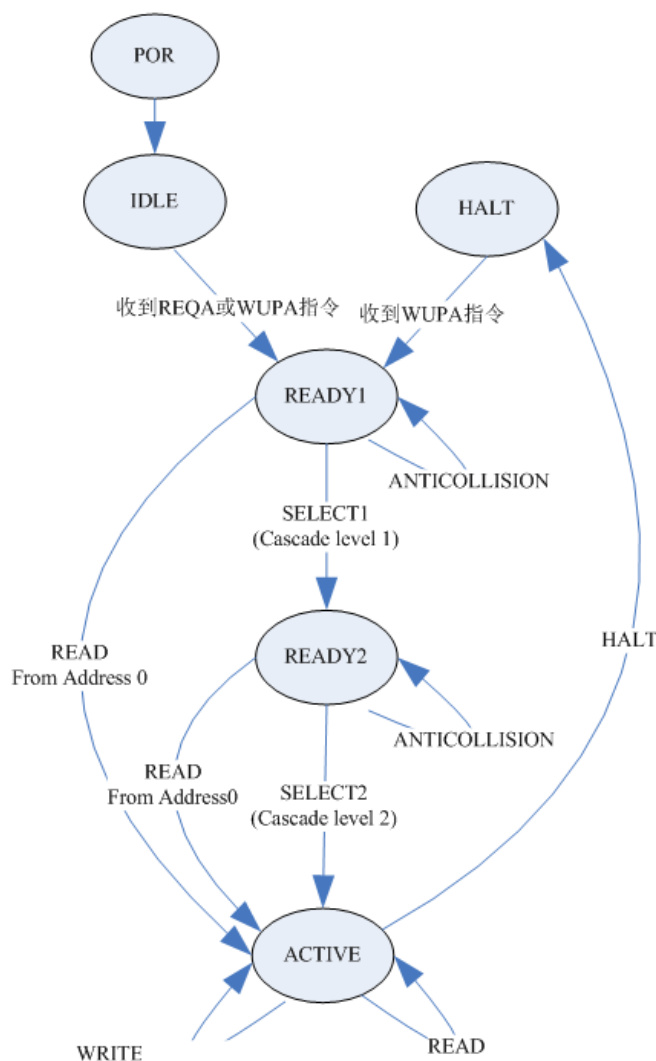


图 4-1 非接触工作流程

## 4.3 场能量对外供电

### 4.3.1 概述

NT082C 支持利用射频场能量对外供电的功能。为了稳定供电，建议在 VOUT 管脚外接 1 $\mu$ F 以上的稳压电容。

### 4.3.2 供电能力

供电能力与读写器或手机发出的场强大小、读写器和标签的天线尺寸、标签和读写器之间的距离等多个因素有关，一般情况下，手机发出的场的最大供电能力约为 10mA 左右。

输出电压默认最高 3.6V，随着芯片接收到的场强变弱，或者 VOUT 的负载变大，VOUT 的电压会降低。

### 4.3.3 开关配置

为保持供电稳定性，通常 VOUT 管脚需要外接较大的稳压电容，比如 1 $\mu$ F。按照 NFC 规定，手机从开场到发出第一条寻卡指令的时间不能小于 6ms，利用这段时间，足够把 1 $\mu$ F 电容充满，因此可选择上电即开启对外供电开关的方式，通过配置 USER\_CFG0 的 Vout\_mode 为 10 可实现该功能。

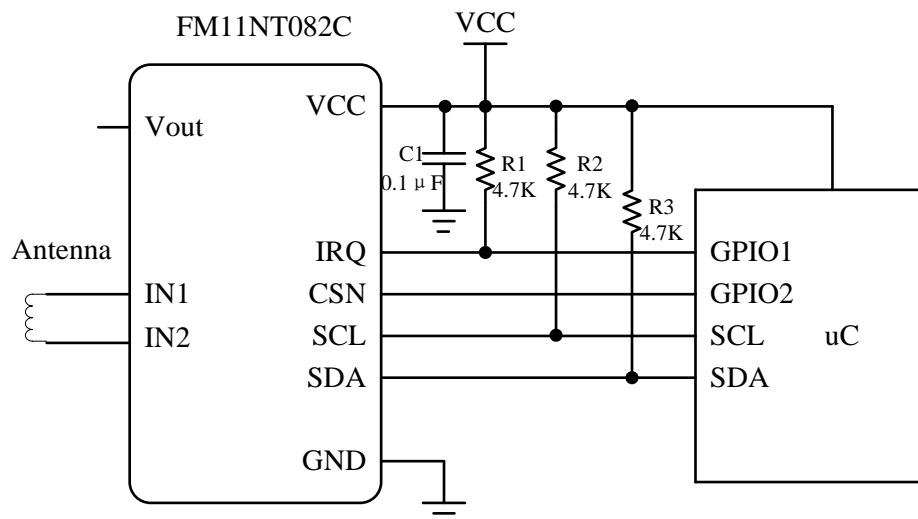
如果外接的电容比较大，比如 10 $\mu$ F 以上，仅靠 6ms 时间难以将电容充满。由于给电容充电的电流较大，会影响手机和标签之间的正常通信，因此建议采用指令开启 Vout\_Switch 的方式，通过配置 USER\_CFG0 的 Vout\_mode 为 11 可实现该功能。开启 Vout\_Switch 以后，通过手机端 APP 里面的 READER\_PRESENCE\_CHECK\_DELAY 配置足够的充电时间。

芯片的场供电输出的内阻可以通过 VOUT\_RES\_CFG 进行配置，在开启 Vout\_Switch 之前，先配置合适的内阻，以保证对稳压电容充电期间不会影响芯片的正常工作。电容充电完成后，芯片自动切换到最小内阻状态。

## 4.4 典型应用电路

### 4.4.1 非对外供电应用





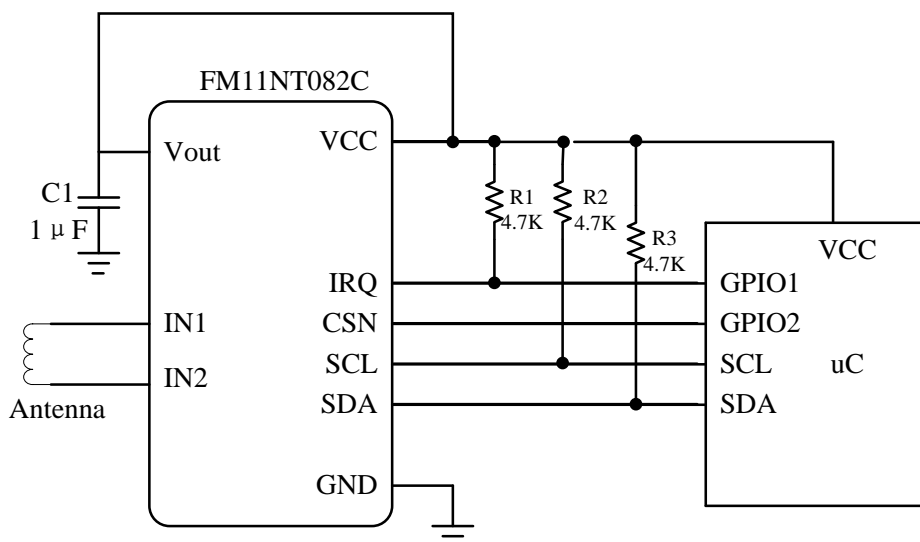
非对外供电应用中，芯片由于零待机功耗，可直接接入系统主电源。

对外供电引脚 **Vout** 悬空。

如果 MCU 的中断输入引脚内建上拉电阻，则不需要 R1；如果 MCU 的 SCL 和 SDA 接口没有内建上拉电阻，则需要在系统上加入上拉电阻，上拉至 VCC，阻值可参考 I2C 总线协议规范。

IRQ 管脚可以通过配置 USER\_CFG0 中的 irq\_mode，选择是推挽输出还是开漏输出，在推挽输出的情况下，可以输出高中断；在开漏输出的情况下，只能输出低中断，芯片外部需要弱上拉至 VCC。

#### 4.4.2 对外供电应用



在对外供电应用中，外部低功耗 MCU 的电源可由芯片的场能量整流后提供，Vout 引脚接 1μF（典型值）电容。

如果 MCU 的中断输入引脚内建上拉电阻，则不需要 R1；如果 MCU 的 SCL 和 SDA 接口没有内建上拉电阻，则需要在系统上加入上拉电阻，阻值可参考 I2C 总线协议规范。



IRQ 管脚可以通过配置 USER\_CFG0 中的 `irq_mode`，选择是推挽输出还是开漏输出，在推挽输出的情况下，可以输出高中断；在开漏输出的情况下，只能输出低中断，芯片外部需要弱上拉至 VCC。



## 5 电气参数

### 5.1 极限额定参数

参数	最小值	最大值	单位
存储温度	-55	+125	°C
最大输入电流 (IN1 对 IN2; 峰值)	-	±30	mA
ESD (HBM)	-	±2000	V
ESD (CDM)	-	±1000	V

表 5-1 极限额定参数【1】

\*注: 如果外加条件超过“极限额定参数”的额定值, 将会对芯片造成永久性的破坏。

\*注: MIL 883 E HBM。

### 5.2 推荐工作条件

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$T_A$	工作温度		-40	+25	+85	°C
$H_A$	天线场强		1.5		7.5	A/M
VCC	VCC 电源电压范围	有射频场	1.62	3.3	5.5	V
		无射频场	2.2	3.3	5.5	V

表 5-2 推荐工作条件

### 5.3 电参数

#### 5.3.1 管脚电参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_i$	非接触界面输入频率	【1】	13.553	13.56	13.567	MHz
$C_i$	输入谐振电容	IN1 和 IN2 之间		50		pF
数字输入管脚 (PIN6、7、8)						
$V_{IL}$	输入低电平		0		0.3Vcc	V
$V_{IH}$	输入高电平		0.7Vcc		Vcc	V
$I_{leak}$	输入漏电流				1	uA
数字输出管脚 (PIN9、PIN10)						
VOH	输出高电平	Vcc=3.3V, $I_O=4mA$	0.7 Vcc		Vcc	V
VOL	输出低电平	Vcc=3.3V, $I_O=4mA$	0		0.3 Vcc	
开漏输出管脚 (PIN8、PIN10)						
VOL	输出低电平	Vcc=3.3V, $I_O=4mA$	0		0.3 Vcc	

表 5-3 管脚电参数

注【1】：频宽依据 ISM 频段规定

### 5.3.2 芯片电参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{SB1}$	接触接口待机电流	25°, VCC=3.3V, SSN/CSN 管脚为高			100	nA
$I_{SB2}$	接触接口静态电流	25°, VCC=3.3V, SSN/CSN 管脚为低, 无通信数据		35		uA
$I_{EE\_WR}$	接触接口擦写 EEPROM 工作电流	25°, VCC=3.3V, I2C 接口时钟 400KHz		150		uA
$V_{out}$	VOUT 管脚输出电压范围	-40~85°	1.5【1】	3.3	3.6	V
$I_{out}$	VOUT 管脚最大输出电流	-40~85°		10【2】		mA

表 5-4 芯片电参数

注【1】：VOUT 管脚输出的是非接触场整流的电压，受标签与读写器天线的相对位置影响较大。

注【2】：VOUT 管脚最大输出电流与读写器发出的场强、标签的天线尺寸、标签和读写器天线的相对位置关系很大，对于 NFC 手机，场整流电流一般最大 10mA 左右。

### 5.3.3 I2C 接口交流参数

推荐参数的适用工作条件：T<sub>BA B</sub> = -40°C ~ +85°C, V<sub>BCCB</sub> = +2.2V ~ +3.6V, CL = 100 pF（除非另有说明）。测试条件参见“注 2”。

符号	参数	Standard(400kHz)			Fast(1MHz)			单位
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
$t_{BLOWB}$	时钟脉宽低电平时间	1.3			0.5			us
$t_{BHIGHB}$	时钟脉宽高电平时间	0.6			0.32			us
$t_{BIB\ 1}$	噪声抑制时间			80			80	ns
$t_{BAAB}$	时钟低至数据有效时间	0.4			0.4			us
$t_{BBUF\ B\ 1}$	两次指令间的总线空闲时间	1.3			0.5			us
$t_{BHD.STAB}$	起始条件保持时间	0.6			0.25			us
$t_{BSU.STAB}$	起始条件建立时间	0.6			0.25			us
$t_{HD.DATB}$	数据保持时间	0			0			ns
$t_{BSU.DATB}$	数据建立时间	100			50			ns
$t_{BRB}$	输入上升时间			300			120	ns
$t_{BFB}$	输入下降时间			300			120	ns
$t_{BSU.STOB}$	停止条件建立时间	0.6			0.25			us
$t_{BDHB}$	数据输出保持时间	100			100			ns
$t_{BWRB}$	写时间			5			5	ms

表 5-5 I2C 接口交流参数



- 注:
- 【1】 该参数由特性测试确定，产品未经 100%测试。
  - 【2】 交流参数测试条件：  
RL (接至 VCC): 1.3 kΩ  
输入脉冲电压: 0.3 VCC ~ 0.7 VCC  
输入上升/下降时间: ≤ 50 ns  
输入/输出时序参考电压: 0.5 VCC

5.4 存储器参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t <sub>ret</sub>	数据保存时间	环境温度 55 度	20			年
N <sub>endu(W)</sub>	擦写次数	环境温度 25 度	100			万次

表 5-6 存储器参数

## 6 封装信息

### 6.1 TDFN10 封装

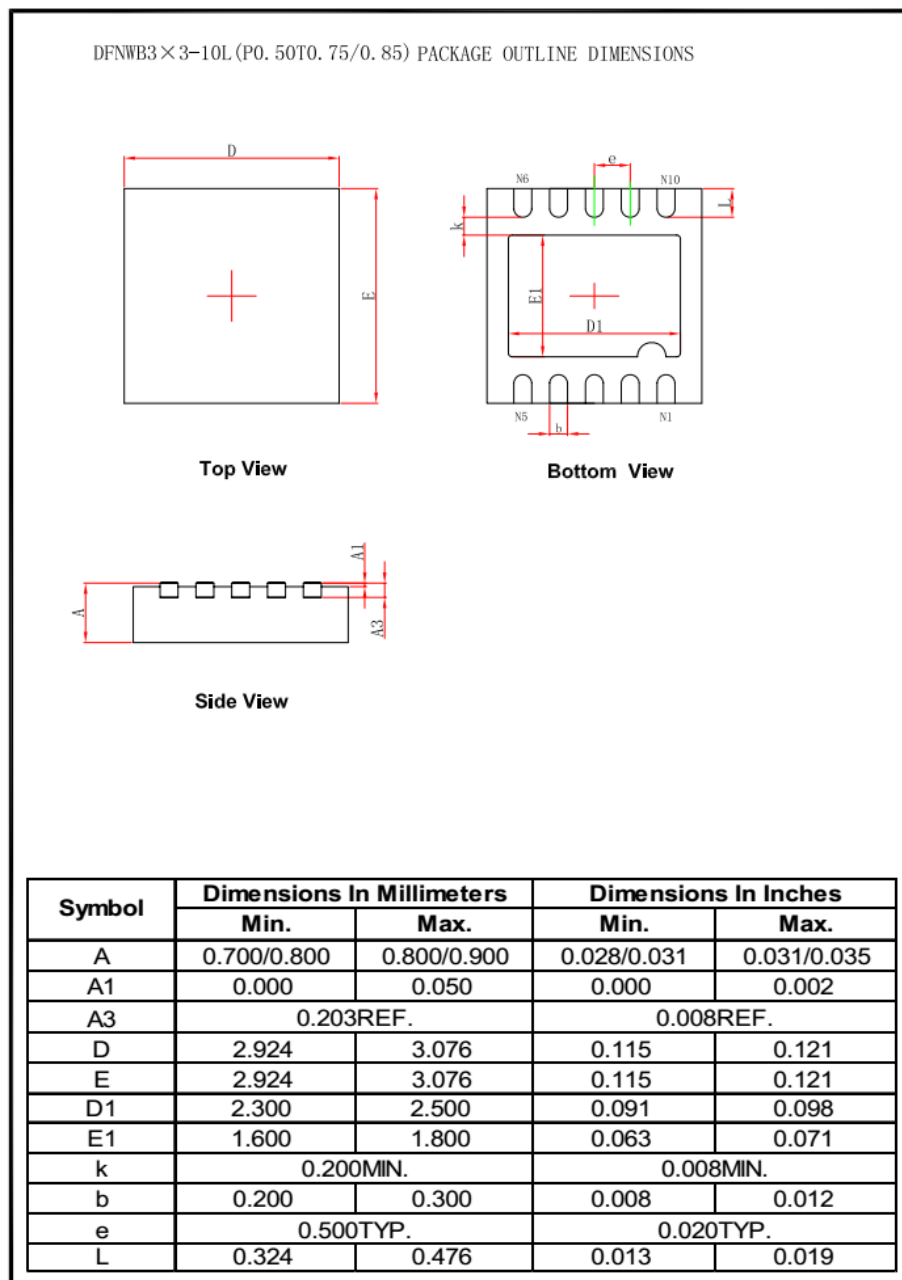


图 6-1 TDFN10 封装尺寸图

注：本产品的封装厚度是 0.75mm。

## 6.2 SOP8 封装

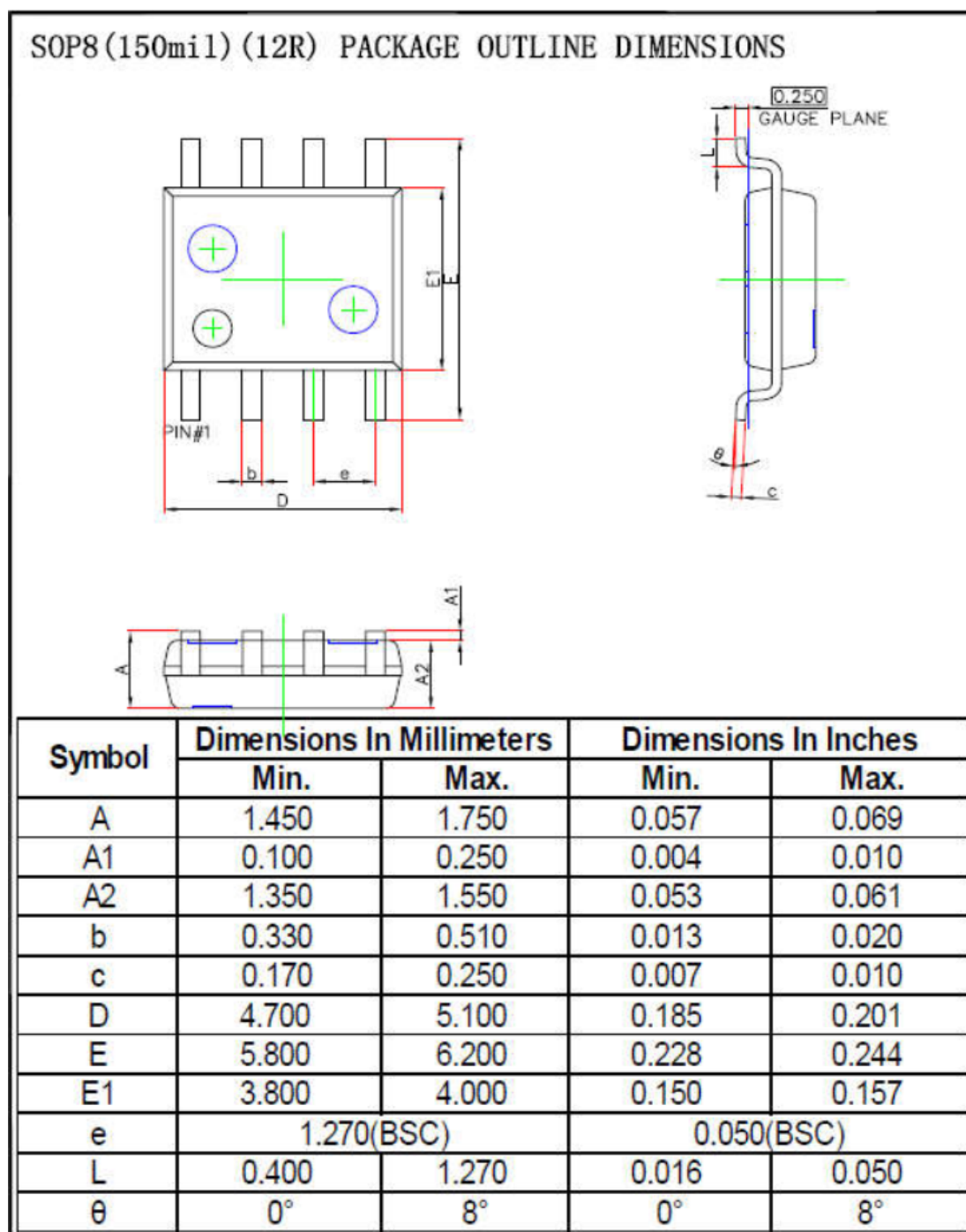


图 6-2 SOP8 封装尺寸图

## 7 订货信息

器件代号	封装形式	包装方式
FM11NT082C-NTCI-DNC-T-G	TDFN10	Tape and Reel
FM11NT082C-NTCI-SO-T-G	SOP8	Tape and Reel
FM11NT082C-NTCZ-DNC-T-G	TDFN10	Tape and Reel
FM11NT082C-NTCZ-SO-T-G	SOP8	Tape and Reel



	FM	11NT	08	2	X	-	XXX	-XXX	-T	-G
公司名前缀										
FM=上海复旦微电子集团股份有限公司										
产品族										
11NT= 符合 ISO/IEC14443-A 协议的 NFC 双界面标签产品										
产品容量										
08=约 8k bits EEPROM										
产品版本										
2=第二代芯片										
接口类型										
C=双界面标签及通道芯片										
子型号										
NTCI=静态锁定位 (CL Static Lock Bytes) 出厂默认为 FFFFh										
NTCZ=静态锁定位 (CL Static Lock Bytes) 出厂默认为 0000h										
封装形式										
DNC=TDFN10, SO=SOP8										
产品载体										
T= Tape and Reel										
U= Tube										
HSF 代码										
G=ROHS Compliant, Halogen-free, Antimony-free										



## 版本信息

版本号	发布日期	页数	更改说明
1.0	2021.10	49	初稿
1.1	2022.1	49	更新图 3-2，接触接口 EEPROM 存储空间分配
1.2	2022.3	49	增加产品子型号说明





## 上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务中心

### 上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

### 上海复旦微电子（香港）有限公司

地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

### 北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608

传真：(86-10) 8418 6211

### 深圳办事处

地址：深圳南山区西丽街道留仙大道创智云城 A7 座 2306-08

邮编：518000

电话：(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611

传真：(86-0755) 8335 9011

### 台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889

传真：(886-2) 7722 3888

### 新加坡办事处

地址：47 Kallang Pudding Road, #08-06, The Crescent @ Kallang, Singapore 349318

电话：(65) 6443 0860

传真：(65) 6443 1215

### 复旦微电子（美国）公司

地址：97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose, CA 95112

电话：(+1)408-335-6936

公司网址：<http://www.fmsk.com/>